



主要特点

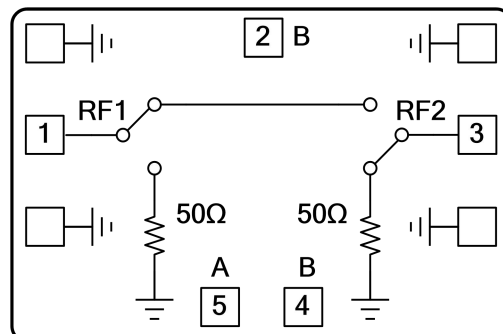
隔离度: 48 dB @ 20 GHz

插入损耗: 1.9 dB @ 20 GHz

匹配式设计

芯片尺寸: $1.5 \times 1 \times 0.1 \text{ mm}^3$

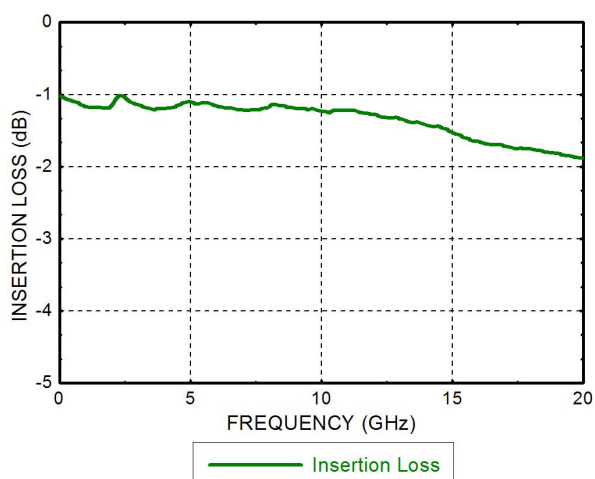
功能框图



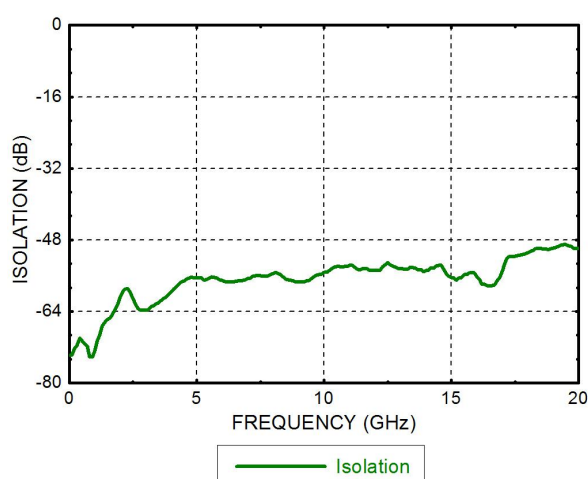
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0/-5 \text{ V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 20			GHz
插入损耗		1.9		dB
隔离度		48		dB
回波损耗“打开状态”		22		dB
回波损耗“关闭状态”		22		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-20GHz		25		dBm
开关切换时间		15		ns

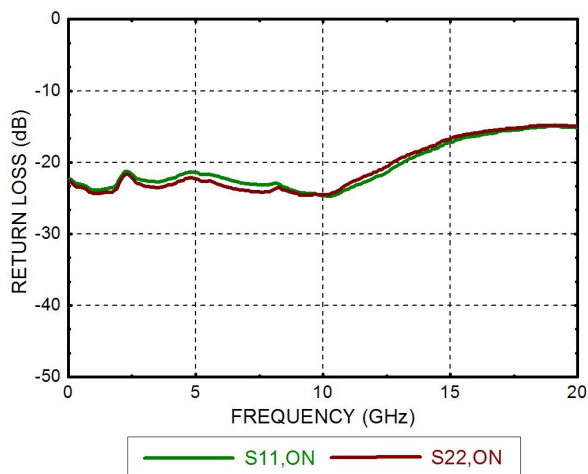
插入损耗



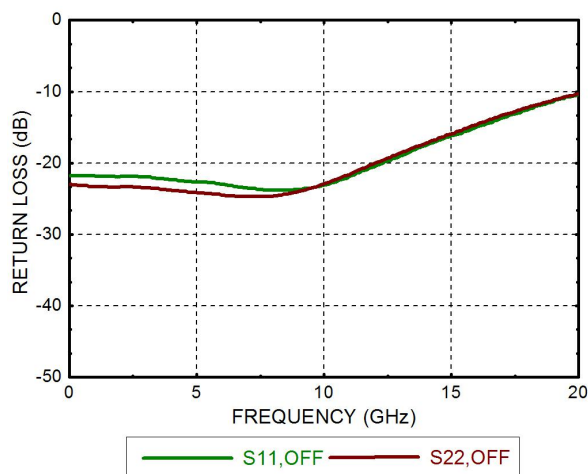
隔离度



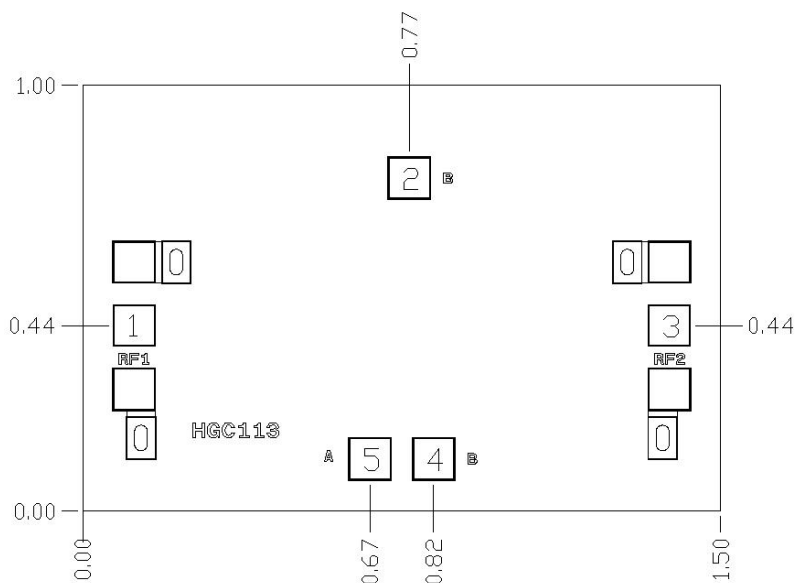
回波损耗, “ON” 状态



回波损耗, “OFF” 状态



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 3	RF1, RF2	该焊盘是 DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容
4, 5	B, A	A=0V, B=-5V, 则 RF1、RF2 为 “ON” 状态; A=-5V, B=0V, 则为 “OFF” 状态
2	B	开关控制可选端
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

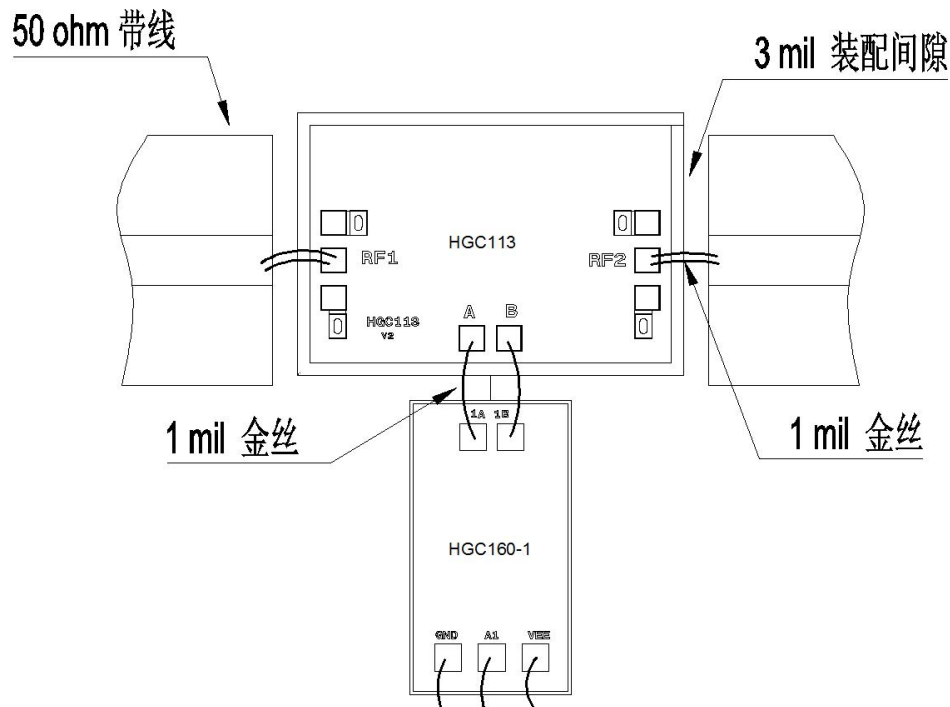


真值表

功能	A	B
ON	0	1
OFF	1	0

“0”电平范围：0~-0.2V，“1”电平范围：-3~-6V。

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150°C
3. 工作温度：-55 ~ +85°C